

СПИСОК
публикаций проф. Глинского Г.Ф.

1. Миронова М.С., Яковлев Г.Е., Зубков В.И., Глинский Г.Ф. Развитие неразрушающего метода диагностики рНМТ структур с квантовыми ямами AlGaAs/InGaAs/GaAs на основе анализа спектров фотолюминесценции. Сб. статей 5-ой всероссийской конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ», т.1, стр.27, СПб, 2016.
2. G.F. Glinskii and M.S. Mironova. An 8-band Kane model for quantum-sized heterostructures based on cubic semiconductors A3B5. J. Phys.: Conf. Ser., 572, 012052 (2014).
<http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/572/1/012052>
3. M.S. Mironova, O.S. Komkov, D.D. Firsov and G.F. Glinskii. Determination of InSb/AlInSb quantum well energy spectrum. J. Phys.: Conf. Ser., 541, 012085 (2014).
<http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/541/1/012085>
4. G.F. Glinskii and M.S. Mironova. Effective hamiltonians for heterostructures based on direct gap III-V semiconductors. The kp perturbation theory and the method of invariants. Semiconductors, Vol.48, No. 10, pp. 1324-1334 (2014).
<http://dx.doi.org/10.1134/S106378261410008X>
5. M.V. Baranovskiy and G.F. Glinskii. Rapid photoelectric diagnostics of LEDs based on InGaN/GaN heterostructures. Technical Physics Letters Vol. 39, No. 5, pp. 460-462.
<http://dx.doi.org/10.1134/S1063785013050179>
6. M.V. Baranovskiy, G.F. Glinskii and M.S. Mironova. Photoelectric diagnostics method for InGaN/GaN multiple-quantum-well heterostructures. Semiconductors, Vol. 47, No. 1, pp. 58-62 (2013).
<http://dx.doi.org/10.1134/S1063782613010053>
7. G.F. Glinskii, M.S. Mironova. Inter-valley mixing in Si/SiO2 heterostructures. J. Phys.: Conf. Ser., 461, 012040 (2013).
<http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/461/1/012040>
8. M.V. Baranovskiy and G.F. Glinskii. Photoconductivity of InGaN/GaN multiple quantum well heterostructures. J. Phys.: Conf. Ser., 461, 012039 (2013).
<http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/461/1/012039>
9. Г.Ф. Глинский. Методы теории групп в квантовой механике. (монография) СПб., Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012, 200 с.
<http://www.twirpx.com/file/1014645/>
10. Г.Ф. Глинский. Полупроводники и полупроводниковые наноструктуры: симметрия и электронные состояния. (монография) СПб., Изд-во «Технолит», 2008, 324 с.
<http://www.twirpx.com/file/1014651/>
11. Глинский Г.Ф. Эффекты размерного квантования в полупроводниковых наноструктурах. В кн. Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы / Под ред. Лучинина В.В., Таирова Ю.М. – ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 552 с.
<http://www.twirpx.com/file/217878/>
12. Г.Ф. Глинский, А.В. Андрианов, О.М. Сресели, Н.Н. Зиновьев. Терагерцовая электролюминесценция за счет пространственно не прямых переходов в квантово-каскадной структуре GaAs/AlGaAs // ФТП, 2005, том 39, вып. 10, с. 1224.